

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
3. Oktober 2002 (03.10.2002)

PCT

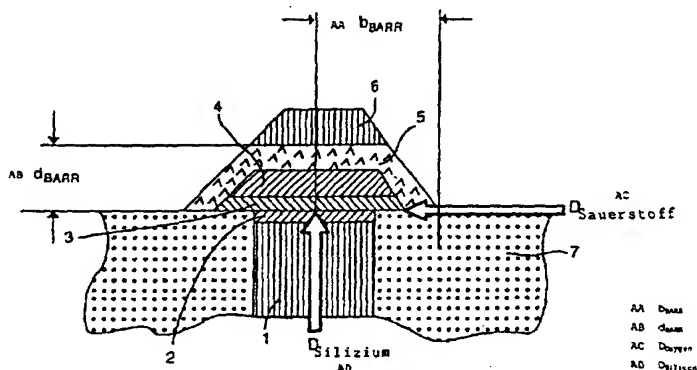
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 02/078084 A2

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01L 21/8246, 21/02 (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KASKO, Igor [BY/DE]; Hans-Mielich-Str. 23, 81543 München (DE). KROENKE, Matthias [DE/DE]; Nordstr. 20, 01099 Dresden (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE02/01054
- (22) Internationales Anmeldedatum: 22. März 2002 (22.03.2002) (74) Anwalt: KOTTMANN, Dieter; Müller, Hoffmann & Partner, Patentanwälte, Innere Wiener Str. 17, 81667 München (DE).
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, KR, US.
- (30) Angaben zur Priorität: 101 14 406.7 23. März 2001 (23.03.2001) DE (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (DE, FR, GB, IE, IT, NL).
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Str. 53, 81669 München (DE). Veröffentlicht: — ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING FERROELECTRIC MEMORY CELLS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG FERROELEKTRISCHER SPEICHERZELLEN



WO 02/078084 A2

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing ferroelectric memory cells in accordance with the stack principle. According to said method, an adhesive layer (2, 3) is formed between a lower capacitor electrode (6) of a memory capacitor and a conductive plug (1), which is formed below said electrode and makes an electric connection between said capacitor electrode (6) and a transistor electrode of a selection transistor that is formed in or on a semiconductor wafer. An oxygen diffusion barrier (4, 5) is formed above the adhesive layer and once the ferroelectric has been deposited, the adhesive layer and the barrier are subjected to rapid thermal processing (RTP) in an oxygen atmosphere. The method is characterised by the following steps: (A) Determination of the oxygen speed of the adhesive layer (2, 3) and the diffusion coefficient ($D_{\text{Oxygen}}(T)$) of oxygen in the material of the adhesive layer (2, 3), dependent on the temperature (T); (B) Determination of the diffusion coefficient ($D_{\text{Silicon}}(T)$) of silicon in the material of the adhesive layer (2, 3), dependent on the temperature and (C) Calculation of an optimal temperature range for the RTP step from the two diffusion coefficients, ($D_{\text{Oxygen}}(T)$) and ($D_{\text{Silicon}}(T)$) that have been determined for a predetermined layer thickness (d_{BARR}) and layer width (b_{BARR}) of the layer system consisting of the adhesive layer and the oxygen diffusion barrier, so that during the RTP step the siliconisation of the adhesive layer occurs more rapidly than its oxidation.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Docket # MUH-12757

Applic. # _____

Applicant: MATTHIAS KROENKE ET AL.

Lerner and Greenberg, P.A.

Post Office Box 2480

Hollywood, FL 33022-2480

Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung ferroelektrischer Speicherzellen nach dem Stackprinzip, wobei zwischen einer unteren Kondensatorelektrode (6) eines Speicherkondensators und einem darunter gebildeten leitenden Plug (1), der zur elektrischen Verbindung dieser Kondensatorelektrode (6) mit einer Transistorelektrode eines in oder auf einem Halbleiterwafer gebildeten Auswahltransistors dient, eine Haftschrift (2, 3) und über der Haftschrift eine Sauerstoffdiffusionsbarriere (4, 5) gebildet und nach der Abscheidung des Ferroelektrikums einem RTP-Schritt in einer Sauerstoffatmosphäre unterworfen werden, wobei das Verfahren durch folgende Schritte gekennzeichnet ist: (A) Ermittlung der Oxidationsgeschwindigkeit der Haftschrift (2, 3) und des Diffusionskoeffizienten ($D_{\text{Sauerstoff}}(T)$) von Sauerstoff im Material der Haftschrift (2, 3) in Abhängigkeit von der Temperatur (T); (B) Ermittlung des Diffusionskoeffizienten ($D_{\text{Silizium}}(T)$) von Silizium in dem Material der Haftschrift (2, 3) in Abhängigkeit von der Temperatur und (C) Berechnung eines optimalen Temperaturbereichs für den RTP-Schritt aus den zuvor ermittelten beiden Diffusionskoeffizienten ($D_{\text{Sauerstoff}}(T)$ und $D_{\text{Silizium}}(T)$) für eine vorgegebene Schichtdicke (d_{BARR}) und Sauerstoffdiffusionsbarriere, so dass während des RTP-Schritts die Silizidierung der Haftschrift schneller abläuft als ihre Oxidation.

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
3. Oktober 2002 (03.10.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 02/078084 A3

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01L 21/8246.
21/02, 21/768

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KASKO, Igor
[BY/DE]: Hans-Mielich-Str. 23, 81543 München (DE).
KROENKE, Matthias [DE/DE]: Nordstr. 20, 01099
Dresden (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE02/01054

(22) Internationales Anmeldedatum:
22. März 2002 (22.03.2002)

(74) Anwalt: KOTTMANN, Dieter; Müller, Hoffmann &
Partner, Patentanwälte, Innere Wiener Str. 17, 81667
München (DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, KR, US.

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent
(DE, FR, GB, IE, IT, NL).

(30) Angaben zur Priorität:
101 14 406.7 23. März 2001 (23.03.2001) DE

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

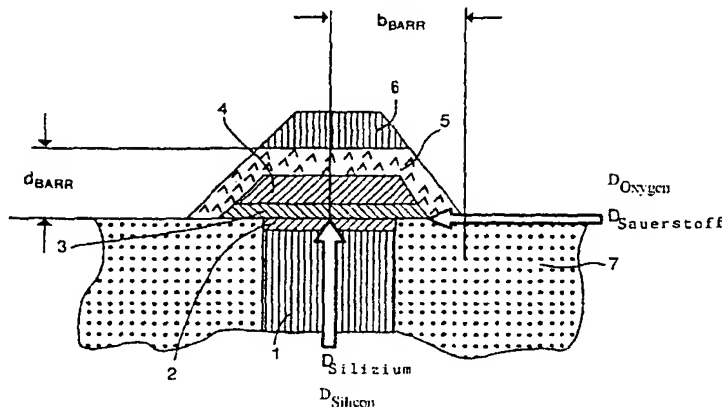
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-
Martin-Str. 53, 81669 München (DE).

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen
Recherchenberichts: 13. März 2003

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING FERROELECTRIC MEMORY CELLS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG FERROELEKTRISCHER SPEICHERZELLEN



(57) Abstract: The invention relates to a method for producing ferroelectric memory cells in accordance with the stack principle. According to said method, an adhesive layer (2, 3) is formed between a lower capacitor electrode (6) of a memory capacitor and a conductive plug (1), which is formed below said electrode and makes an electric connection between said capacitor electrode (6) and a transistor electrode of a selection transistor that is formed in or on a semiconductor wafer. An oxygen diffusion barrier (4, 5) is formed above the adhesive layer and once the ferroelectric has been deposited, the adhesive layer and the barrier are subjected to rapid thermal processing (RTP) in an oxygen atmosphere. The method is characterised by the following steps: (A) Determination of the oxygen speed of the adhesive layer (2, 3) and the diffusion coefficient ($D_{\text{Oxygen}}(T)$) of oxygen in the material of the adhesive layer (2, 3), dependent on the temperature (T); (B) Determination of the diffusion coefficient ($D_{\text{Silicon}}(T)$) of silicon in the material of the adhesive layer (2, 3), dependent on the temperature and (C) Calculation of an optimal temperature range for the RTP step from the two diffusion coefficients, ($D_{\text{Oxygen}}(T)$) and ($D_{\text{Silicon}}(T)$) that have been determined for a predetermined layer thickness (d_{BARR}) and layer width (b_{BARR}) of the layer system consisting of the adhesive layer and the oxygen diffusion barrier, so that during the RTP step the silicisation of the adhesive layer occurs more rapidly than its oxidation.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 02/078084 A3



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Docket # MUH-12757

Applic. # _____

Applicant: MATTHIAS KROENKE ET AL.

Lerner and Greenberg, P.A.

Post Office Box 2480

Hollywood, FL 33022-2480

Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung ferroelektrischer Speicherzellen nach dem Stackprinzip, wobei zwischen einer unteren Kondensatorelektrode (6) eines Speicherkondensators und einem darunter gebildeten leitenden Plug (1), der zur elektrischen Verbindung dieser Kondensatorelektrode (6) mit einer Transistorelektrode eines in oder auf einem Halbleiterwafer gebildeten Auswahltransistors dient, eine Haftschrift (2, 3) und über der Haftschrift eine Sauerstoffdiffusionsbarriere (4, 5) gebildet und nach der Abscheidung des Ferroelektrikums einem RTP-Schritt in einer Sauerstoffatmosphäre unterworfen werden, wobei das Verfahren durch folgende Schritte gekennzeichnet ist: (A) Ermittlung der Oxidationsgeschwindigkeit der Haftschrift (2, 3) und des Diffusionskoeffizienten ($D_{\text{Sauerstoff}}(T)$) von Sauerstoff im Material der Haftschrift (2, 3) in Abhängigkeit von der Temperatur (T); (B) Ermittlung des Diffusionskoeffizienten ($D_{\text{Silizium}}(T)$) von Silizium in dem Material der Haftschrift (2, 3) in Abhängigkeit von der Temperatur und (C) Berechnung eines optimalen Temperaturbereichs für den RTP-Schritt aus den zuvor ermittelten beiden Diffusionskoeffizienten ($D_{\text{Sauerstoff}}(T)$ und $D_{\text{Silizium}}(T)$) für eine vorgegebene Schichtdicke (d_{BARR}) und Sauerstoffdiffusionsbarriere, so dass während des RTP-Schritts die Silizidierung der Haftschrift schneller abläuft als ihre Oxidation.